

ОТСУТСТВИЕ ПАРАМАГНИТНОГО ПРЕДЕЛА ДЛЯ H_{c211} В СЛОИСТЫХ СВЕРХПРОВОДНИКАХ БЕЗ ЦЕНТРА ИНВЕРСИИ

Л.Н.Булаевский, А.И.Русинов

Показано, что наблюдаемое превышение парамагнитного предела для верхнего критического магнитного поля, параллельного слоям, в слоистых сверхпроводниках $TaS_2(Py)_{1/2}$ и $NbSe_2$ может быть связано со спин-орбитальным взаимодействием в решетке без центра симметрии.

Согласно экспериментальным данным, верхнее критическое магнитное поле H_{c211} , параллельное слоям, в слоистых сверхпроводниках $2H - TaS_2(Py)_{1/2}$ и $2H - NbSe_2$ превосходит парамагнитный предел $H_p = \Delta_0 / \mu_B \sqrt{2}$ (Δ_0 – сверхпроводящая щель при $T = 0$, μ_B – магнетон Бора). Так в интеркалированном соединении TaS_2 с пиридином (Py) при $T = 1,4K$ сверхпроводимость не разрушается в поле $H_p = 150$ кэ ($T_c = 3,25K$ и $H_p = 60$ кэ) [1]. В $NbSe_2$ парамагнитный эффект не оказывает никакого влияния на величину H_{c211} , и при $T = 1,4K$ поле $H_{c211} (\approx 130$ кэ) определяется только орбитальным эффектом ($T_c = 7K$ и $H_p = 130$ кэ) [2].

В принципе подавление парамагнитного эффекта в слоистых сверхпроводниках может быть связано с реализацией в них неоднородного

состояния [3, 4], триплетным спариванием электронов из соседних слоев [5] и спин-орбитальным рассеянием на примесях. Однако неоднородное состояние и спаривание электронов соседних слоев чувствительны к рассеянию электронов на примесях внутри слоев, и они разрушаются при длине свободного пробега электрона внутри слоя $l \lesssim \xi_0 = \hbar v_F / \pi \Delta_0$ [4]. По оценкам [3] в $\text{TaS}_2(\text{Py})_{1/2}$ отношение $\xi_0 / l = 1 + 6$, и примерно таков же диапазон изменения ξ_0 / l для разных кристаллов NbSe_2 . Между тем экспериментально не замечена зависимость $H_c 211$ от степени чистоты образцов. Спин-орбитальное рассеяние также приводит к существенному подавлению парамагнитного эффекта при длине свободного пробега электрона с изменением спина $l_{so} \lesssim \xi_0$, а поскольку $l_{so} / l \lesssim 10^{-2}$, то в слоистых сверхпроводниках $l_{so} \gg \xi_0$, и спин-орбитальное рассеяние меняет парамагнитный предел незначительно.. Кроме того, и в этом случае наблюдалась бы сильная чувствительность $H_c 211$ к степени чистоты кристаллов.

Ниже мы покажем, что подавление парамагнитного эффекта в слоистых соединениях можно объяснить спин-орбитальным взаимодействием электронов проводимости в кристалле без центра симметрии (в кристалле с центром симметрии спин-орбитальное взаимодействие не меняет свойства сверхпроводника в магнитном поле [6]). Для предположения об отсутствии центра симметрии в решетке олоистых сверхпроводников есть некоторые основания. Высокотемпературные 2Н-модификации TaS_2 и NbSe_2 обладают центром инверсии. Однако при понижении температуры в них наблюдаются структурные переходы металл – металл, связанные, по-видимому, с появлением волны зарядовой плотности внутри слоев [7]. Не исключено, что при этих переходах центр симметрии теряется (например, при несоизмеримости волны зарядовой плотности и периода решетки высокотемпературной фазы новая решетка не может обладать центром симметрии). Интеркалирование TaS_2 пиридином подавляет структурный переход, но молекулы пиридина в сильной степени понижают симметрию решетки в плоскости слоев из-за несоизмеримости размеров молекулы и периода решетки TaS_2 в слое [8].

В решетке без центра инверсии спин-орбитальное взаимодействие электрона с квазимпульсом \mathbf{k} может быть записано в виде $\partial[\vec{\epsilon}_1 \mathbf{k}] / k_F$. В [3] показано, что в $\text{TaS}_2(\text{Py})_{1/2}$ в не очень близкой окрестности T_c движение электронов можно считать двумерным, и поле $H_c 211$ определяется только парамагнитным эффектом. Тогда зависимость T_c от H_{II} определяется из уравнений

$$g \operatorname{Sp} \sum_{\omega} \int d^2 \mathbf{k} G(\omega, \mathbf{k}, \vec{\sigma}) G(-\omega, -\mathbf{k}, -\vec{\sigma}) = 1, \quad \omega = \pi T(2n + 1),$$

$$G^{-1}(\omega, \mathbf{k}, \vec{\sigma}) = i\omega - \epsilon_0(\mathbf{k}) + \vec{\sigma}(\mu_B H + [\vec{\epsilon}_1 \mathbf{k}] / k_F),$$

где g – константа электрон-фононного взаимодействия, $\epsilon_0(\mathbf{k})$ – та часть энергии электрона, которая не зависит от спина. В слоистых сверхпроводниках вектор $\vec{\epsilon}_1$ должен лежать в плоскости слоев, и тогда при $\epsilon_1 \ll \hbar \omega_D$ уравнение (1) преобразуется к виду

$$\ln \frac{T_{co}}{T} = 2\pi T \sum_{\omega > 0} \frac{h^2}{\omega \sqrt{(\omega^2 + h^2)(\omega^2 + h^2 + \epsilon_1^2)}}, \quad h = \mu_B H. \quad (2)$$

При $h \gg T_c$ получаем из (2) выражение для $T_c(H)$

$$T_c(H) = T_{co}(\Delta_0/2Hf)^a, \quad a = (\sqrt{1 + \epsilon_1^2/h^2} - 1)^{-1}, \quad (3)$$
$$f = 2\sqrt{(1 + h^2/\epsilon_1^2)(1 + 2h^2/\epsilon_1^2 - 2h/\epsilon_1\sqrt{1 + h^2/\epsilon_1^2})}.$$

Из (3) видно, что при любом значении ϵ_1 величина $T_c(H) \neq 0$, т. е. парамагнитный предел при $T = 0$ не существует. При $\epsilon_1 > T_{co}$ имеем $T_c(H) \approx T_{co}$ при $h \ll \epsilon_1$, и $T_c(H)$ убывает с ростом H лишь при $h \gtrsim \epsilon_1$. Эти результаты нечувствительны к рассеянию электронов на примесях внутри слоев. Однако влияние спин-орбитального взаимодействия на парамагнитный эффект существенно зависит от взаимной ориентации H , ϵ_1 и р. Так если ϵ_1 перпендикулярен плоскости слоев, то при $\epsilon_1 \gg H \gg T_{co}$ получаем $H_{c211} = \sqrt{2}H_p$ при $T = 0$. В трехмерном изотропном случае парамагнитный предел зависит от угла между H и ϵ_1 и парамагнитный предел неограниченно растет при приближении направления H к ϵ_1 .

Предложенная модель позволяет объяснить высокие значения H_{c211} в $TaS_2(Py)_{1/2}$ и независимость H_{c211} от парамагнитного эффекта в низкотемпературной фазе анизотропного сверхпроводника $2H - NbSe_2$. Отметим, что высокотемпературную фазу $2H - NbSe_2$ можно сохранить при низких температурах в метастабильном состоянии, она является сверхпроводящей [9], и в этой фазе в рамках нашей модели парамагнитный эффект должен влиять на H_{c211} при низких температурах. Сpin-орбитальное взаимодействие в решетке без центра симметрии приводит также к появлению найтовского сдвига в сверхпроводящем состоянии [10], поскольку существует прямая корреляция между превышением парамагнитного предела и величиной парамагнитной восприимчивости. Поэтому в $NbSe_2$ и $TaS_2(Py)_{1/2}$ должен наблюдаться сильно анизотропный найтовский сдвиг (в поле H этот сдвиг не должен меняться существенно при переходе из нормального в сверхпроводящее состояние). Все другие упомянутые выше механизмы подавления парамагнитного эффекта дают изотропный сдвиг Найта в сверхпроводящей фазе.

Физический институт

Поступила в редакцию

28 ноября 1974 г.

им. П.Н.Лебедева

После переработки

11 декабря 1974 г.

Академии наук ССР

Литература

- [1] R.C.Morris, R.V.Coleman. Phys. Rev., 137, 991, 1973.
- [2] S.Foner, E.J.McNiff Jr. Phys. Lett., 45A, 429, 1973.
- [3] Л.Н.Булаевский. ЖЭТФ, 64, 2241; 65, 1278, 1973.
- [4] K.Aoi, W.Dieterich, P.Fulde. Z. Phys., 267, 223, 1974.
- [5] К.Б.Ефетов, А.И.Ларкин. ЖЭТФ, 68, вып.1, 1974 г.
- [6] Л.П.Горьков. ЖЭТФ, 43, 1772, 1965.
- [7] J.A.Wilson, F.J.Di Salvo, S.Mahajan. Phys. Rev. Lett., 32, 882, 1972.
- [8] R.B.Murray, R.H.Williams. Phil. Mag., 29, 473, 1974.
- [9] K.Jamaya, J. Phys. Soc. Japan, 37, 36, 1974.
- [10] А.И.Русинов. Краткие сообщения по физике, ФИАН ССР, 9, 19, 1972.